**电子科技大学磁控溅射系统采购项目采购公告**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 0773-1841GNSCHWGK0486 |
| 公告类型 | 公开招标 |
| 公告发布时间 | 2018年03月13日 |
| 采购代理机构名称 | 中金招标有限责任公司 |
| 代理机构地址 | 成都市高新区天晖路360号（高新区管委会旁）晶科1号2006号 |
| 代理机构联系人 | 郑啸 |
| 代理机构联系电话 | 028-84469198 |
| 采购人地址 | 成都市高新区（西区）西源大道2006号 |
| 采购人联系人 | 刘老师 |
| 采购人联系电话 | 028-61830995 |
| 项目联系电话 | 028-84469198 |
| 项目包个数 | 1 |
| 项目联系人 | 袁先生 |
| 供应商资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件；7、根据采购项目提出的特殊条件；8、本项目不接受联合体参与投标。（详见招标文件第四章）。 |
| 获取招标文件的方式和事项 | 现场发售。供应商购买招标文件时须携带下列有效证明文件：1、单位介绍信或授权书原件。（须注明被介绍人或被授权人的姓名、联系方式、具体项目名称，办理事项内容或授权范围等内容并加盖单位公章，同时提供被介绍人或被授权人的身份证复印件加盖单位公章。）2、供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。 |
| 获取招标文件的地点 | 成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司 |
| 标书发售起止时间 | 2018年03月14日至2018年03月20日09:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外） |
| 标书售价（元） | 人民币300元/份 |
| 标书发售地点 | 成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司 |
| 投标截止时间 | 2018年04月03日上午10：00（北京时间） |
| 开标时间 | 2018年04月03日上午10：00（北京时间） |
| 投标地点 | 成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司 |
| 开标地点 | 成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司 |
| 预算金额（单位：元） | 采购预算：145万元 |
| 招标项目基本情况、用途、采购需求、数量、简要技术要求 | 磁控溅射系统,一套。（允许进口产品参与竞争）包括超高真空多靶磁控溅射系统、样品台、溅射靶枪系统、靶枪电源、预真空室load-lock、真空系统、气路系统、控制系统。（详见招标文件） |
| 采购项目需要落实的政府采购政策 | 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《四川省政府采购当事人诚信管理办法》、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《无线局域网产品政府采购实施意见》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》、《四川省政府采购当事人诚信管理办法》、《合同法》 |
| 有无考察或标前答疑 | 否 |
| 是否允许联合体 | 不允许 |
| 是否采购本国货物和服务 | 是  |
| 采购品目 | 专业设备采购 |
| 采购品目名称 |  |
| 行业划分 | 货物 |
| 备注 | 本项目采购预算及最高限价：145万元整；招标公告公示期为5个工作日。 |
| PPP项目标识 | 不是 |

附件：

#### 一、技术参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编码** | **设备名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 一． | **超高真空多靶磁控溅射系统** | 该设备具有可控制的磁场、稳定的氩气控制方案，可在超高真空环境中制备制备纳米级单层及多层功能功能薄膜，主要为多层磁性异质结、磁性隧道结、合金薄膜、半导体和氧化物薄膜等。 | 套 | 1 |  |
| 二． |  | **设备主要配置及技术指标：** |  |  |  |
|  | **样品台** | * 1. 具备溅射4英寸及以下尺寸基片的能力；

1.2 ▲ 样品台可以在0-40RPM的范围内匀速转动；1.3 ▲ 样品台可加热，可在氧气环境下加热，加热温度≥850摄氏度，SHQ-15A PID控制，带TC输入，过温保护，控温稳定性≤±1摄氏度；1.4 ★ 主腔体配备楔形挡板，可制备楔形薄膜样品。 | 套 | 1 |  |
|  | **溅射靶枪系统** | 2.1 ★ 至少配置7套超高真空共溅射靶枪，1套正溅射靶枪，其中至少4套强磁靶枪；靶材尺寸不小于2英寸；靶枪防氧化设计，可进行反应溅射和低压运行，共溅射采用向上溅射工作模式，工作距离可调节；2.2 所有靶枪均须配置独立气动挡板，通气装置以及隔离套筒，防止交叉污染。所有靶枪磁铁全部采用稀土磁铁材质，可被烘干至200℃，适应真空度10E-11 Torr环境，无需在烘干系统前移除磁铁。磁铁安装在水冷系统外，确保后续维护、清洁、故障排除和维修的便利；2.3 ★ 4英寸硅片成膜均匀性：至少达到±2.5%；2.4 投标人需要提供其他用户使用投标设备制备CoFeB/MgO/CoFeB磁隧道结的案例证明。 | 套 | 8 |  |
|  | **靶枪电源** | 3.1▲ 靶枪电源包括：至少配置2个750W 直流电源（750W及以上，含4路转换器和输出电缆）；3.2▲ 至少配置1个射频电源（功率不小于300W），带自动匹配网络及输出电缆；1个射频电源4路转换器； | 套 | 3 |  |
| 1.
 |  **预真空室load-lock** | 4.1 配置磁性传送杆；4.2 配置分子泵组系统,分子泵抽速至少80l/s;；4.3 配置全量程真空计，最低测试真空可达10-11Torr以上；4.4 预真空腔室室与主腔室之间有手动插板阀； | 套 | 1 |  |
|  | **真空系统** | 5.1★ 配备冷凝泵系统，抽速至少4000l/s,，极限真空至少达到2x10-8Torr；5.2 真空检测系统带同步显示三个测头输出信号；  | 套 | 1 |  |
|  | **气路系统** | 6.1▲ 至少配置2路工艺气体管路（Ar和反应气体），质量流量计带气动隔离阀和过滤器；6.2采用下游压力控制，通过真空计和PID控制器精确控制气压。 | 套 | 2 |  |
|  | **控制系统** | 7.1▲ 提供可编程Labview 软件控制系统；Windows图形用户界面和显示屏，软件具有可编程自动控制能力，并能够通过显示屏实时显示系统真空，工艺气体流量，溅射功率, 溅射时间等工艺参数及工艺过程。带有5个直流和4个射频电源接口，用于输出模式、定点、线性缓慢升温和等离子检测控制；7.2 操作软件应具备带多项自动保护功能、系统故障自检功能和提示报警功能；不少于100个单独密码保证工艺膜层和工艺安全性，采用多级进入系统操作，确保系统运行和真空控制的安全性；7.3 独立的实时控制系统来实现设备操控，计算机死机或者程序退出不影响设备运行；7.4 设备联网后可实现远程控制，异地工程师可进行远程操作进行维护、检查调试；7.5 具有开关位置/直流电源反馈，直流偏压反馈（射频），等离子体识别，工艺气压，气体流反馈，T/C温度反馈，并能将数据实时显示在PC上； | 套 | 1 |  |

#### 二、商务及其他要求

**1. 本项目付款方式：合同签订后预付30%，原厂预验收后发货前付60%，验收后付10%。**

### 2. 售后服务

**2.1** 免费保修期：验收合格之日起不少于1年。